

● 功率 MOSFET 基本特点

功率场效应晶体管又称功率MOSFET，在实际应用中，它有着比晶体管更好的特性，在电机调速，开关电源等各种领域应用非常广泛。

功率MOSFET优点表现在以下几个方面：

- 1、具有较高的开关速度。
- 2、具有较宽的安全工作区而不会产生热点，并且具有正的温度系数，因此适合并联使用。
- 3、具有较高的可靠性。
- 4、具有较强的过载能力，短时过载能力是通常额定值的 4 倍。
- 5、具有较高的开启电压，即阈值电压，可达2~6V（一般在1.5V~5V之间）。当环境噪声较高时，可选用阈值电压较高的管子，以提高抗干扰能力；反之，当噪声较低时，选用阈值电压较低的管子，以降低所需的输入驱动信号电压，给电路设计带来了极大地方便。
- 6、功率MOSFET为电压控制器件，具有很高的输入阻抗，驱动功率很小，对驱动电路要求较低。

● 功率 MOSFET 的选型

稳定的工作，且寿命满足要求。要求MOS管的过渡过程要足够快，以便减少开关损耗；导通电阻足够小，以便减少导通损耗；关断电阻足够大，以便提高隔离作用，同时还要兼顾成本，下面给出设计中重点考虑的参数：

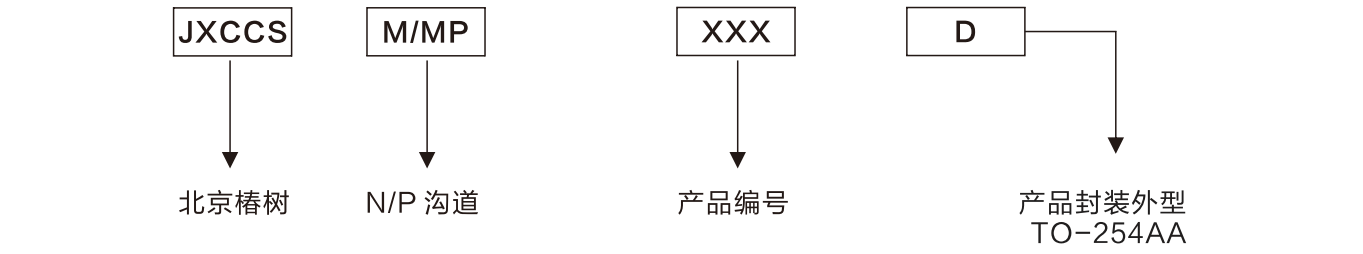
- (1) 耐压 BV_{DSS} (V)
- (2) 导通时的漏极电流 I_D (A)
- (3) 最大耗散功率 P_D (W)
- (4) 最高工作温度 T_j (℃)
- (5) 导通时的漏源极间电阻 $R_{DS(on)}$ (mΩ)
- (6) 输入电容 C_{iss} (pF)
- (7) 上升时间 t_r (ns) 导通时间 t_{on} (ns) 下降时间 t_f (ns) 关断时间 t_{off} (ns) 反向恢复时间 t_{rr} (ns)
- (8) 栅极总电荷 Q_g (nC)
- (9) 热阻 R_{th} (K/W)

● 功率 MOSFET 驱动电路设计

MOS管对栅极驱动电路的要求：

- 栅极驱动电路的延迟时间要小，有助于减少 V_{gs} 的上升时间。
- 栅极驱动电路的输出峰值电流要大，可以大大缩短电容充放时间。
- 栅极驱动电压的变化率 dv/dt 要大，可以大大缩短 V_{gs} 的上升和下降时间。满足上述要求的栅极驱动电路，能够加快MOS管转换过程，减少MOS管的开关损耗，栅极驱动电路有与用的IC。

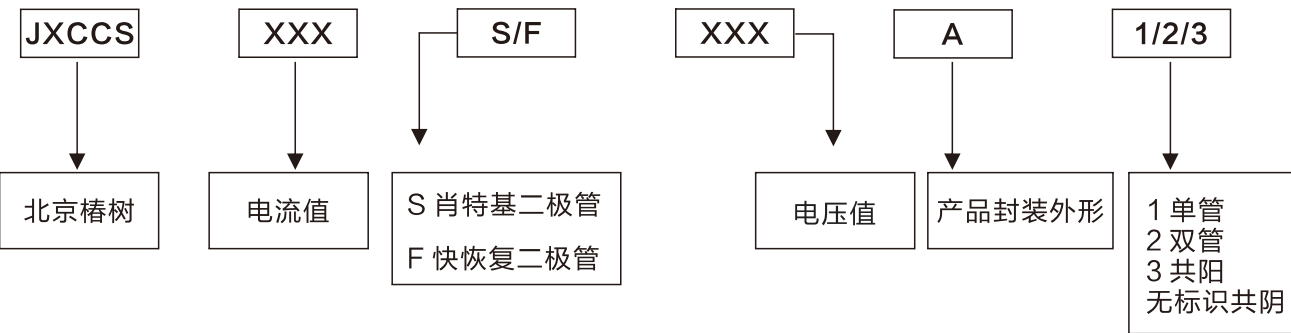
● 功率 MOSFET 型号命名



产品封装外形对照表

英文代号	封装外形	英文代号	封装外形
A	TO-39	J	LCC-18
B	TO-3	K	HTO-267AA
C	TO-257AA	L	SMD-3
D	TO-254 AA	M	PB-3A
E	TO-258 AA	N	T2
F	TO-259 AA	P	SMD-0.2
G	SMD-0.5	Q	SMD-0.1
H	SMD-1	R	LCC-3
I	SMD-2		

● 型号命名方法



英文代号	封装外形	英文代号	封装外形
A	TO-39	J	LCC-18
B	TO-3	K	HTO-267AA
C	TO-257AA	L	SMD-3
D	TO-254AA	M	PB-3A
E	TO-258AA	N	T2
F	TO-259AA	P	SMD-0.2
G	SMD-0.5	Q	SMD-0.1
H	SMD-1	R	LCC-3
I	SMD-2		

● 瞬态电压抑制二极管介绍

瞬态电压抑制二极管（Transient Voltage Suppressor）简称TVS，是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时，它能以10的负12次方秒量级的速度，将其两极间的高阻抗变为低阻抗，吸收高达数千瓦的浪涌功率，使两极间的电压箝位于一个预定值，有效地保护电子线路中的精密元器件，免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点，目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。

TVS二极管有单向不双向之分，单向TVS管的特性不稳压二极管相似，双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联，其主要特性参数有：

- （1）反向断态电压（截止电压） V_{RWM} 不反向漏电流 I_R ：
反向断态电压（截止电压） V_{RWM} 表示TVS二极管开通时的最高工作电压，在这个电压下只有很小的反向漏电流 I_R 。
- （2）击穿电压 V_{BR} ：TVS二极管通过规定的测试电流 I_T 时的电压，这是表示TVS管导通的标志电压。
- （3）脉冲峰值电流 I_{PPM} ：TVS二极管允许通过的10/1000 μs 波的最大峰值电流（8/20 μs 波的峰值电流约为其5倍左右），超过这个电流值就可能造成永久性损坏。在同一个系列中，击穿电压越高的管子允许通过的峰值电流越小。
- （4）最大箝位电压 V_C ：TVS二极管流过脉冲峰值电流 I_{PPM} 时两端所呈现的电压。
- （5）脉冲峰值功率 P_{PPM} ：脉冲峰值功率是 P_{PPM} 指10/1000 μs 波的脉冲峰值电流 I_{PPM} 不最大箝位电压 V_C 的乘积，即 $P_{PPM} = I_{PPM} * V_C$ 。
- （6）稳态功率 P_D ：TVS二极管也可以作稳压二极管用，这时要使用稳态功率。
- （7）极间电容 C_{PP} ：TVS二极管的极间电容 C_{PP} 较大，功率越大的电容也越大。在选用TVS时必须根据电路的具体条件而定，一般有以下几点原则：
 - （1）最大箝位电压不大于电路的最大允许电压；
 - （2）箝位电压不低于电路的最大工作电压；
 - （3）在标准脉冲持续时间10-1000us下测定的最大允许脉冲功率必须大于电路中出现的峰值脉冲功率。

JXCCSM3002 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



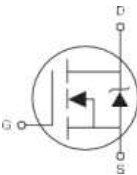
SMD-0.2

JXCCSM3002

$I_D: 2A$

$R_{DS(ON)}: 0.115\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.115	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=2A$
		—	—	0.2	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=2A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3003 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



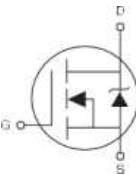
SMD-0.2

JXCCSM3003

$I_D: 3A$

$R_{DS(ON)}: 0.13\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.07	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=3A$
		—	—	0.13	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=3A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3005 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



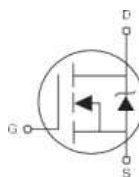
SMD-0.2

JXCCSM3005

$I_D: 5A$

$R_{DS(ON)}: 0.035\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	—	—	—
		—	—	0.035	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=5A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3007 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



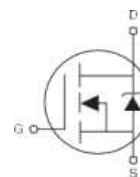
SMD-0.2

JXCCSM3007

$I_D: 7A$

$R_{DS(ON)}: 0.045\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

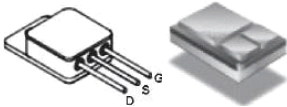
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.03	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=7A$
		—	—	0.045	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=7A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3010 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



TO-257 SMD-0.5

JXCCSM3010

$I_D: 10A$
 $R_{DS(ON)}: 0.025\Omega$
 $BV_{DSS}: 30V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$

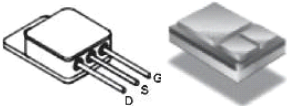
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.015	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=10A$
		—	—	0.025	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=10A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3015 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



TO-257 SMD-0.5

JXCCSM3015

$I_D: 15A$
 $R_{DS(ON)}: 0.015\Omega$
 $BV_{DSS}: 30V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$

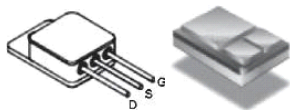
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.009	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=15A$
		—	—	0.015	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=15A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3040 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



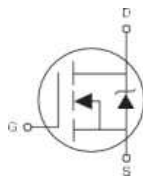
TO-254 SMD-1.0

JXCCSM3040

$I_D: 40A$

$R_{DS(ON)}: 0.025\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

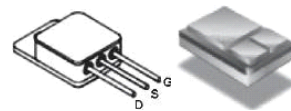
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.018	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=40A$
		—	—	0.025	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=40A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3045 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



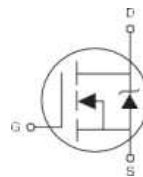
TO-245 SMD-1.0

JXCCSM3045

$I_D: 45A$

$R_{DS(ON)}: 0.02\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

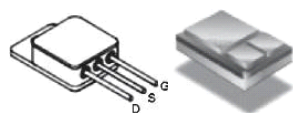
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.01	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=45A$
		—	—	0.02	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=45A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM3060 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



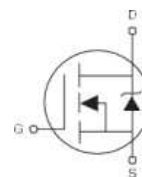
HTO-267 SMD-2.0

JXCCSM3060

$I_D : 60A$

$R_{DS(ON)} : 0.01 \Omega$

$BV_{DSS} : 30V$



电特性: $T_j = 25^\circ C$

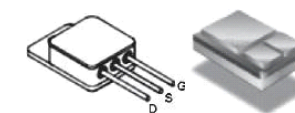
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.006	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 60A$
		—	—	0.01	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 60A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 30V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM3075 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



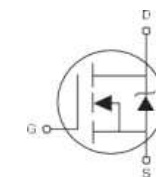
HTO-267 SMD-2.0

JXCCSM3075

$I_D : 75A$

$R_{DS(ON)} : 0.07 \Omega$

$BV_{DSS} : 30V$



电特性: $T_j = 25^\circ C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.004	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 75A$
		—	—	0.007	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 75A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 30V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM6003 N 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装
(2) 低导通电阻
(3) 快速开关
(4) 高输入阻抗
(5) 驱动功率小

外形封装:

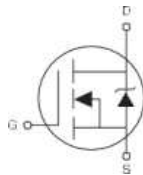


SMD-0.2

JXCCSM6003

$I_D: 3A$
 $R_{DS(ON)}: 0.12\Omega$
 $BV_{DSS}: 60V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.09	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=3A$
		—	—	0.12	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=3A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=48V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM6005 N 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装
(2) 低导通电阻
(3) 快速开关
(4) 高输入阻抗
(5) 驱动功率小

外形封装:

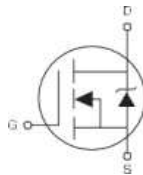


SMD-0.2

JXCCSM6005

$I_D: 5A$
 $R_{DS(ON)}: 0.06\Omega$
 $BV_{DSS}: 60V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



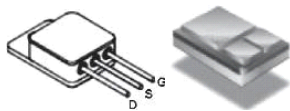
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.05	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=5A$
		—	—	0.06	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=5A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=48V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM6012 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



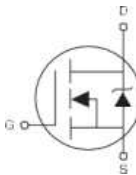
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM6012

$I_D: 12A$

$R_{DS(ON)}: 0.015\Omega$

$BV_{DSS}: 60V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

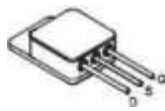
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.012	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 12A$
		—	—	0.015	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 12A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 48V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM6085 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



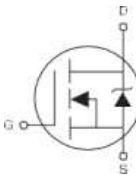
HTO-267

JXCCSM6085

$I_D: 85A$

$R_{DS(ON)}: 0.005\Omega$

$BV_{DSS}: 60V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

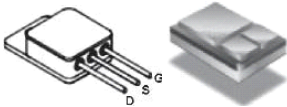
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.005	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 85A$
		—	—	—	—	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 85A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	3	—	5	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 48V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM7540 N 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装
(2) 低导通电阻
(3) 快速开关
(4) 高输入阻抗
(5) 驱动功率小

外形封装:

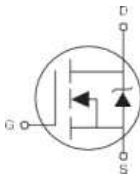


TO-254 SMD-1.0

JXCCSM7540

$I_D: 40A$
 $R_{DS(ON)}: 0.008\Omega$
 $BV_{DSS}: 75V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



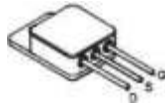
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	75	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.008	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=40A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	3	—	5	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=75V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM7580 N 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装
(2) 低导通电阻
(3) 快速开关
(4) 高输入阻抗
(5) 驱动功率小

外形封装:

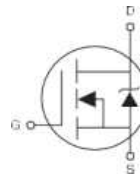


HTO-267

JXCCSM7580

$I_D: 80A$
 $R_{DS(ON)}: 0.012\Omega$
 $BV_{DSS}: 75V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	75	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.012	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=80A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=75V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM05N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:
(1) 标准封装
(2) 低导通电阻
(3) 快速开关
(4) 高输入阻抗
(5) 驱动功率小

外形封装:

SMD-0.2

JXCCSM05N10

$I_D: 5A$
 $R_{DS(ON)}: 0.012\Omega$
 $BV_{DSS}: 100V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.3	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=5A$
		—	—	0.6	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=5A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM07N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:
(1) 标准封装
(2) 低导通电阻
(3) 快速开关
(4) 高输入阻抗
(5) 驱动功率小

外形封装:

SMD-0.2

JXCCSM07N10

$I_D: 7A$
 $R_{DS(ON)}: 0.28\Omega$
 $BV_{DSS}: 100V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$

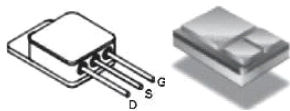
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.185	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=7A$
		—	—	0.28	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=7A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM11N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



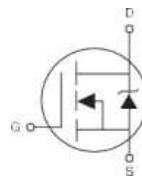
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM11N10

$I_D: 11A$

$R_{DS(ON)}: 0.2\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

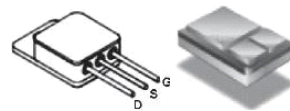
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.12	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=11A$
		—	—	0.2	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=11A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM16N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



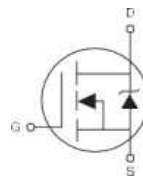
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM16N10

$I_D: 16A$

$R_{DS(ON)}: 0.078\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

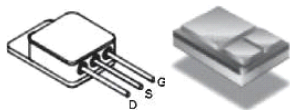
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.078	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=16A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM21N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



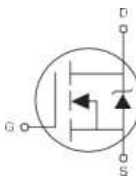
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM21N10

$I_D: 21A$

$R_{DS(ON)}: 0.028\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

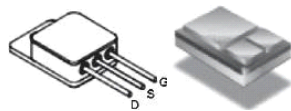
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.028	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=21A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM25N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



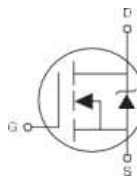
TO-254 SMD-1.0

JXCCSM25N10

$I_D: 25A$

$R_{DS(ON)}: 0.042\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

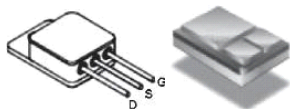
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.042	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=25A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM40N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



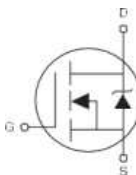
TO-254 SMD-1.0

JXCCSM40N10

$I_D: 40A$

$R_{DS(ON)}: 0.036\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

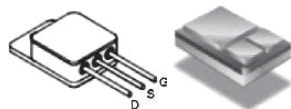
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.036	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=40A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM48N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



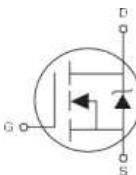
TO-254 SMD-1.0

JXCCSM48N10

$I_D: 48A$

$R_{DS(ON)}: 0.012\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

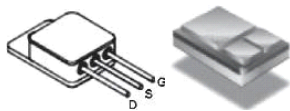
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.012	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=48A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	3	—	5	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM56N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



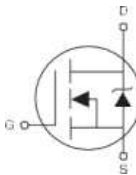
TO-254 SMD-1.0

JXCCSM56N10

$I_D: 56A$

$R_{DS(ON)}: 0.016\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

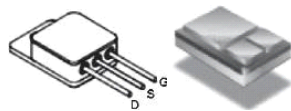
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.016	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 56A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	3	—	5	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 80V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM62N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



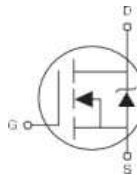
HTO-267 SMD-2.0

JXCCSM62N10

$I_D: 62A$

$R_{DS(ON)}: 0.012\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

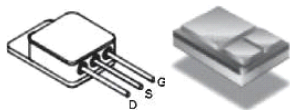
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.012	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 62A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 80V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM70N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
 (2) 低导通电阻
 (3) 快速开关
 (4) 高输入阻抗
 (5) 驱动功率小

外形封装:



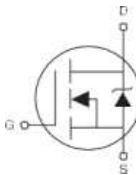
HTO-267 SMD-2.0

JXCCSM70N10

$I_D: 70A$

$R_{DS(ON)}: 0.009\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

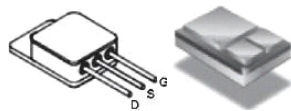
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\ \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.009	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 70A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	3	—	5	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 80V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM75N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
 (2) 低导通电阻
 (3) 快速开关
 (4) 高输入阻抗
 (5) 驱动功率小

外形封装:



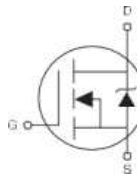
HTO-267 SMD-2.0

JXCCSM75N10

$I_D: 75A$

$R_{DS(ON)}: 0.008\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

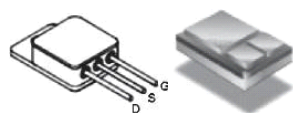
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\ \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.008	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 75A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 80V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM78N10 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



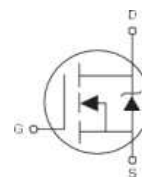
HTO-267 SMD-2.0

JXCCSM78N10

$I_D: 78A$

$R_{DS(ON)}: 0.008\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^\circ C$

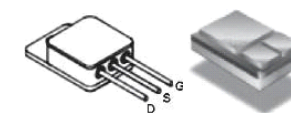
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.008	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 78A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	3	—	5	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 80V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM11N15 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



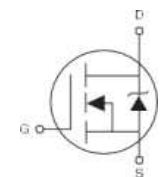
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM11N15

$I_D: 11A$

$R_{DS(ON)}: 0.25\Omega$

$BV_{DSS}: 150V$



电特性: $T_j=25^\circ C$

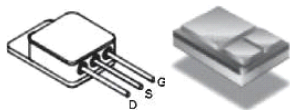
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	150	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.15	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 11A$
		—	—	0.25	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 11A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 150V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 120V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM20N15 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



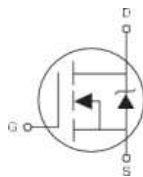
HTO-257 SMD-0.5

JXCCSM20N15

$I_D: 20A$

$R_{DS(ON)}: 0.11\Omega$

$BV_{DSS}: 150V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

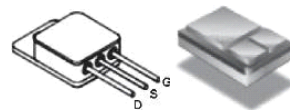
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	150	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.1	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=20A$
		—	—	0.11	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=20A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=150V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=120V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM25N15 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



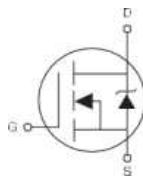
TO-254 SMD-1.0

JXCCSM25N15

$I_D: 25A$

$R_{DS(ON)}: 0.03\Omega$

$BV_{DSS}: 150V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

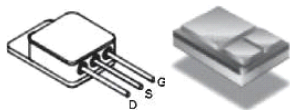
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	150	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.03	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=25A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=150V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=120V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSM06N20 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
 (2) 低导通电阻
 (3) 快速开关
 (4) 高输入阻抗
 (5) 驱动功率小

外形封装:



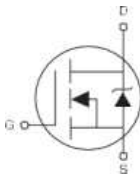
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM06N20

$I_D: 6A$

$R_{DS(ON)}: 0.62\Omega$

$BV_{DSS}: 200V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

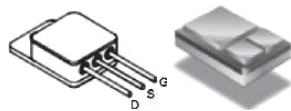
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	200	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.61	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 6A$
		—	—	0.62	Ω	$V_{GS} = 5V, I_D = 6A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 200V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 160V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM08N20 N 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
 (2) 低导通电阻
 (3) 快速开关
 (4) 高输入阻抗
 (5) 驱动功率小

外形封装:



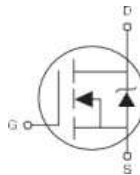
TO-257 SMD-0.5

JXCCSM08N20

$I_D: 8A$

$R_{DS(ON)}: 0.39\Omega$

$BV_{DSS}: 200V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	200	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.39	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 8A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 200V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 160V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSM18N20 N 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装

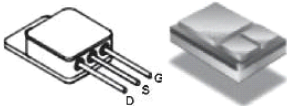
(2) 低导通电阻

(3) 快速开关

(4) 高输入阻抗

(5) 驱动功率小

外形封装:



TO-257 SMD-0.5

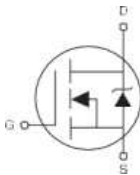
JXCCSM18N20

$I_D: 18A$

$R_{DS(ON)}: 0.18\Omega$

$BV_{DSS}: 200V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	200	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.18	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=18A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=200V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=160V, V_{GS}=0V, T_J=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$